

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【公開番号】特開2007-242848(P2007-242848A)

【公開日】平成19年9月20日(2007.9.20)

【年通号数】公開・登録公報2007-036

【出願番号】特願2006-62495(P2006-62495)

【国際特許分類】

H 01 L	21/28	(2006.01)
H 01 L	21/318	(2006.01)
H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/3205	(2006.01)
H 01 L	23/52	(2006.01)

【F I】

H 01 L	21/28	B
H 01 L	21/318	A
H 01 L	29/78	6 1 6 K
H 01 L	29/78	6 1 6 U
H 01 L	21/28	3 0 1 R
H 01 L	21/88	R

【手続補正書】

【提出日】平成21年1月9日(2009.1.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

基板上にモリブデンを含む層によって逆スタッガード型TFTのソース／ドレイン電極層を形成し、

前記モリブデンを含む層が露出した状態において、前記基板に対し、少なくとも窒素ガスを用いた大気圧プラズマ処理を行い、

前記大気圧プラズマ処理後、前記TFTのチャネルが露出した状態で洗浄を行なう基板の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

基板上に形成された逆スタッガード型TFTのモリブデンを含むソース／ドレイン電極層において、

前記モリブデンを含むソース／ドレイン電極層の表面に形成されたモリブデン窒化物を有する配線基板。